

圖 6-35 IMD-1 之製作。

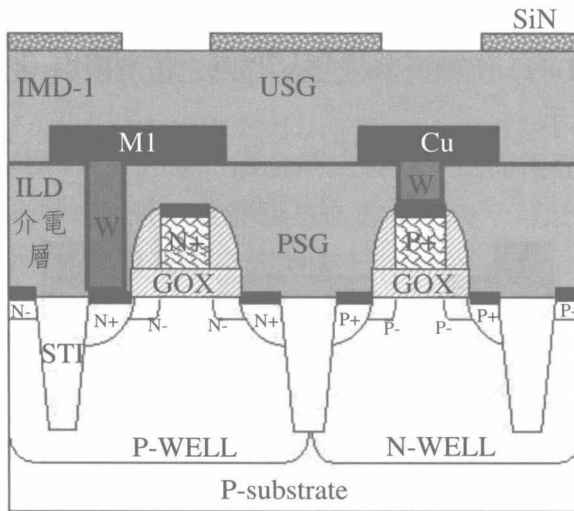


圖 6-36 SiN (etch stop layer) 之形成。

(2)再沉積一層 USG，之後進行 Via-1 的微影及蝕刻，最後再把光阻移除，即形成 Via-1 如圖 6-37 所示。